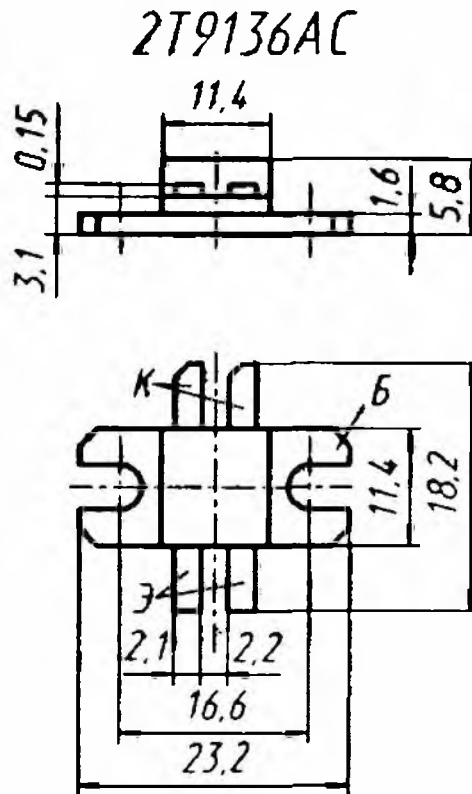


2Т9136АС

Сборка из двух кремниевых эпитаксиально-планарных структуры *n-p-n* генераторных транзисторов. Предназначена для применения в импульсных генераторах, усилителях мощности в диапазоне частот 200...500 МГц в схеме ОБ при напряжении питания 45 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса сборки не более 7 г.



Электрические параметры

Импульсная выходная мощность в двух-
тактной схеме на частоте $f = 500$ МГц при
 $U_{п} = 45$ В, $P_{вх} = 71,4$ Вт, $t_{и} = 250$ мкс, $Q = 10$,
 $T_{к} \leq +40$ °С, не менее 500 Вт

Коэффициент усиления по мощности в двух-
тактной схеме на частоте $f = 500$ МГц при
 $U_{п} = 45$ В, $P_{вх} = 71,4$ Вт, $t_{и} = 250$ мкс, $Q = 10$,
 $T_{к} \leq +40$ °С, не менее 7

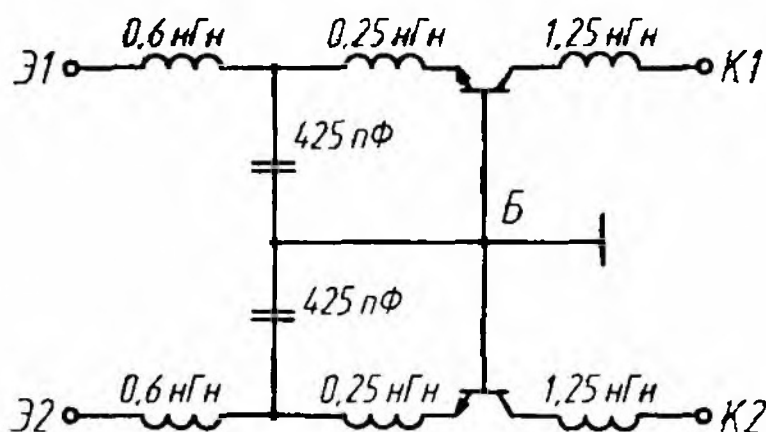
Коэффициент полезного действия в двух-
тактной схеме на частоте $f = 500$ МГц при
 $U_{п} = 45$ В, $P_{вх} = 71,4$ Вт, $t_{и} = 250$ мкс,
 $Q = 10$, $T_{к} \leq +40$ °С, не менее 45%

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 5$ А, $f = 100$ МГц, не менее	3
Критический ток для каждого транзистора при $U_{кз} = 10$ В, на $f = 100$ МГц, не менее	18 А
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 5$ В, $I_3 = 0,5$ А, $f = 5$ МГц, не более	20 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 45$ В, не более	260 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$, не более	3100 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 60$ В, не более	140 мА
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кз} = 45$ В, не более	100 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более	100 мА

Примечание: для $I_{кб0}$, $I_{кзк}$, $I_{эб0}$ приведены суммарные значения двух параллельно включенных транзисторов.

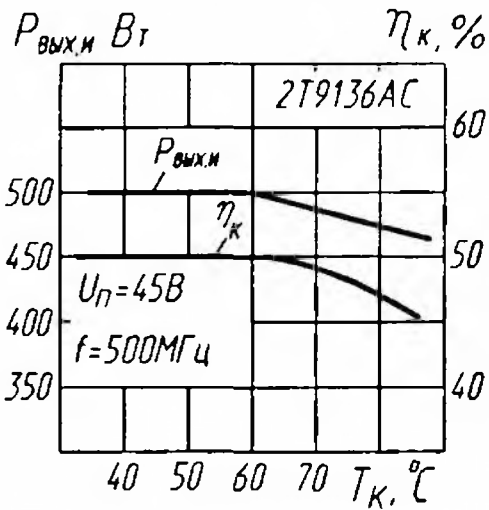
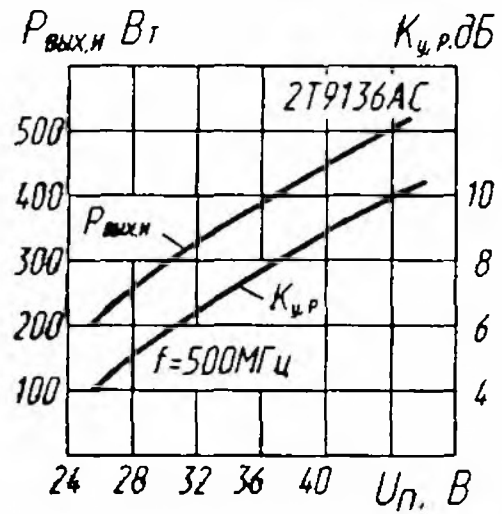
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	60 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	4 В
Импульсный ток коллектора для двух транзисторов при $t_n = 250$ мкс, $Q = 10$	30 А
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_n = 250$ мкс, $Q = 10$, $T_k = +60$ °С	250 Вт
Температура р-п перехода	+200 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_k = +125$ °С

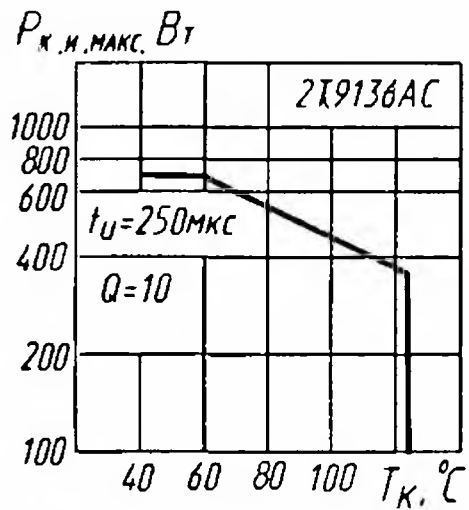


Принципиальная электрическая схема транзисторной сборки 2Т9136АС

Зависимости импульсной выходной мощности и коэффициента усиления от напряжения питания



Зависимости импульсной выходной мощности и коэффициента полезного действия коллектора от температуры корпуса



Зависимость максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса